

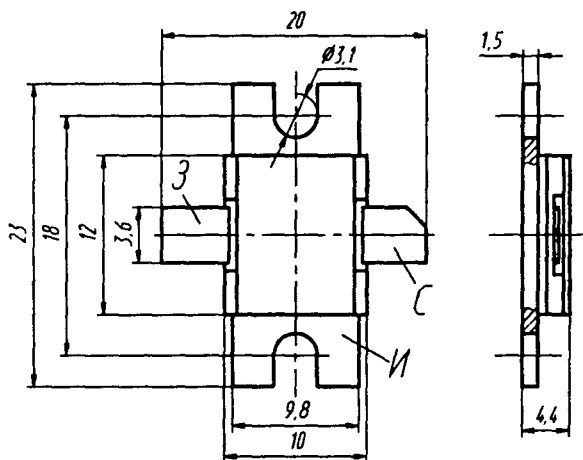
A719A, A719B, A719B, A719Г

Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и каналом л-типа. Предназначены для применения в усилителях мощности и генераторах на частотах до 1 ГГц, а также в быстродействующих переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 8 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

A719 (А-Г)



Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 1$ ГГц, не менее:

A719A при $U_{C \text{ ПИТ}} = 50$ В, $P_{\text{ВХ}} = 20$ Вт 50 Вт

A719Б при $U_{C \text{ ПИТ}} = 45$ В, $P_{\text{ВХ}} = 10$ Вт 25 Вт

A719В при $U_{C \text{ ПИТ}} = 45$ В, $P_{\text{ВХ}} = 7$ Вт 17 Вт

Крутизна характеристики при $U_{CИ} = 20$ В,
не менее:

A719A, $I_C = 3$ А 1 А/В

A719Б, $I_C = 3$ А 0,7 А/В

A719В, $I_C = 2$ А 0,55 А/В

A719Г, $I_C = 2$ А 0,35 А/В

Начальный ток стока при $U_{CИ} = 20$ В, $U_{3И} = 0$,
не более:

A719A, A719Б 50 мА

A719В, A719Г 25 мА

Остаточный ток стока при $U_{\text{си}} = 50 \text{ В}$,

$U_{\text{зи}} = -10 \text{ В}$, не более:

A719A, A719Б 50 мА

A719B, A719Г 25 мА

Ток стока при $U_{\text{си}} = 20 \text{ В}$, $U_{\text{зи}} = 20 \text{ В}$, не менее:

A719A 12 А

A719Б 8 А

A719B 6 А

A719Г 4 А

Сопротивление сток—исток в открытом состоянии при $U_{\text{зи}} = 20 \text{ В}$, $I_c = 1 \text{ А}$, не более:

A719Б 1 Ом

A719Г 3 Ом

Ток утечки затвора при $U_{\text{зи}} = -20 \text{ В}$, не более $1 \cdot 10^{-7} \text{ А}$

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток 50 В

Постоянное напряжение сток—исток в динамическом режиме 70 В

Постоянное напряжение затвор—исток 20 В

Постоянное напряжение затвор—сток 60 В

Постоянная рассеиваемая мощность¹

при $T_k = -60...+35 \text{ °C}$:

A719A, A719Б 100 Вт

A719B, A719Г 50 Вт

Температура окружающей среды $-60...T_k = +125 \text{ °C}$

Транзисторы пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником. Допустимое число перепаяек 3. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 3 мм. Разрешается обрезать выводы на расстоянии не менее 1 мм от корпуса. Минимальное место пайки выводов от корпуса 2 мм, температура припоя $+260 \pm 5 \text{ °C}$, время пайки не более 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 1 мм от корпуса, температура пайки не выше $+150 \text{ °C}$, время пайки не более 3 с. Допускается сварка выводов на расстоянии не менее 1 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать $+150 \text{ °C}$.

Рекомендуется для улучшения отвода тепла от корпуса транзистора применение мягкой прокладки из сплава индий—олово с содержанием индия не менее 20% и жестких металлических прокладок (например, из медной фольги), расположенных под краями фланца с наружной стороны от крепежных винтов. Ориентировочная толщина мягких прокладок 60...100 мкм, жесткой на 5...10 мкм больше. Не допускается применение мягкой прокладки без использования жесткой прокладки.

¹ При $T_k = +35...+125 \text{ °C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно до 20 Вт для A719A, A719Б и до 10 Вт для A719B, A719Г.